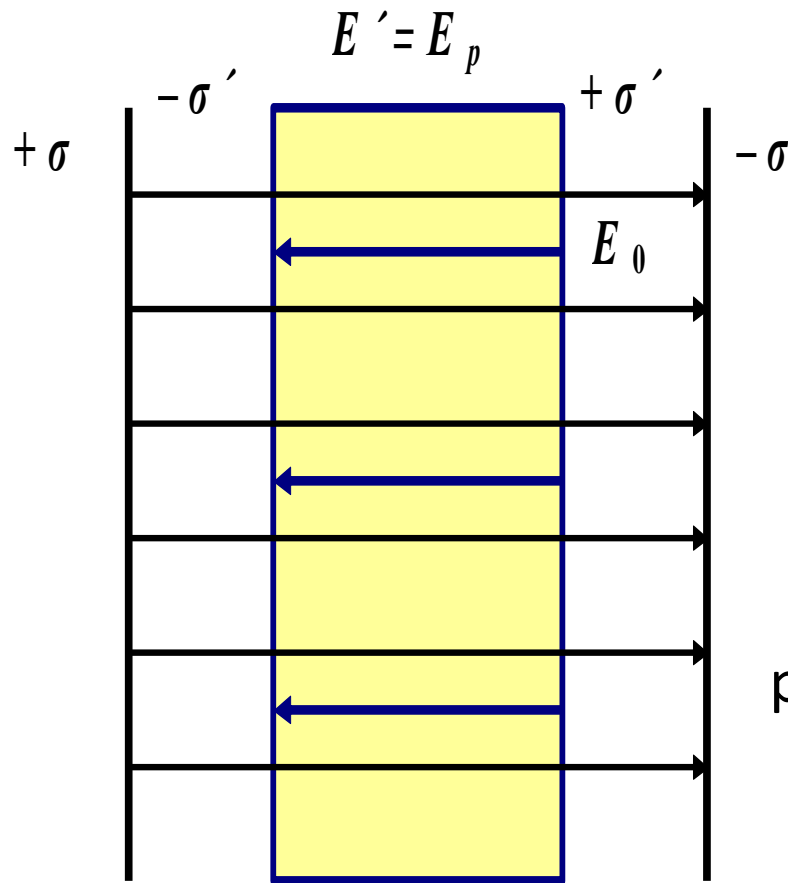


Вектор электростатической индукции.

- Поле в среде отличается от поля в вакууме тем, что оно создается как **свободными**, так и **связанными (поляризационными)** зарядами.
- Теорема Гаусса

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{своб} + q_{пол}}{\epsilon_0}$$

Вектор электростатической индукции.



Свободные заряды создают внешнее поляризующее поле E_0 , а связанные заряды – добавочное поле поляризованного диэлектрика E_p .

$$\vec{E}_p \uparrow \downarrow \vec{E}_0$$

результатирующее поле в диэлектрике:

$$E = E_0 - E_p < E_0$$

Вектор электростатической индукции.

По теореме Гауса для векторов E и P :

$$\oint_S \varepsilon_0 \vec{E} d\vec{S} = q_{своб} + q_{пол} \qquad \oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q_{пол}$$

$$\Rightarrow \oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = q_{своб}$$

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}$$

вектор **электростатической индукции**
(электрического смещения).

Закон Гаусса для вектора электростатической индукции

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{своб}$$

Поток вектора электростатической (электрической) индукции через замкнутую поверхность S **равен** **алгебраической сумме** **свободных зарядов**, охватываемых этой поверхностью.

Закон Гаусса для вектора электростатической индукции

Закон Гаусса для вектора \mathbf{D} в дифференциальном виде:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{D} dV = \int_V \rho dV$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

Связь между векторами \vec{D} и \vec{E}

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$$\boxed{\varepsilon = 1 + \chi}$$

- **относительная
диэлектрическая проницаемость.**

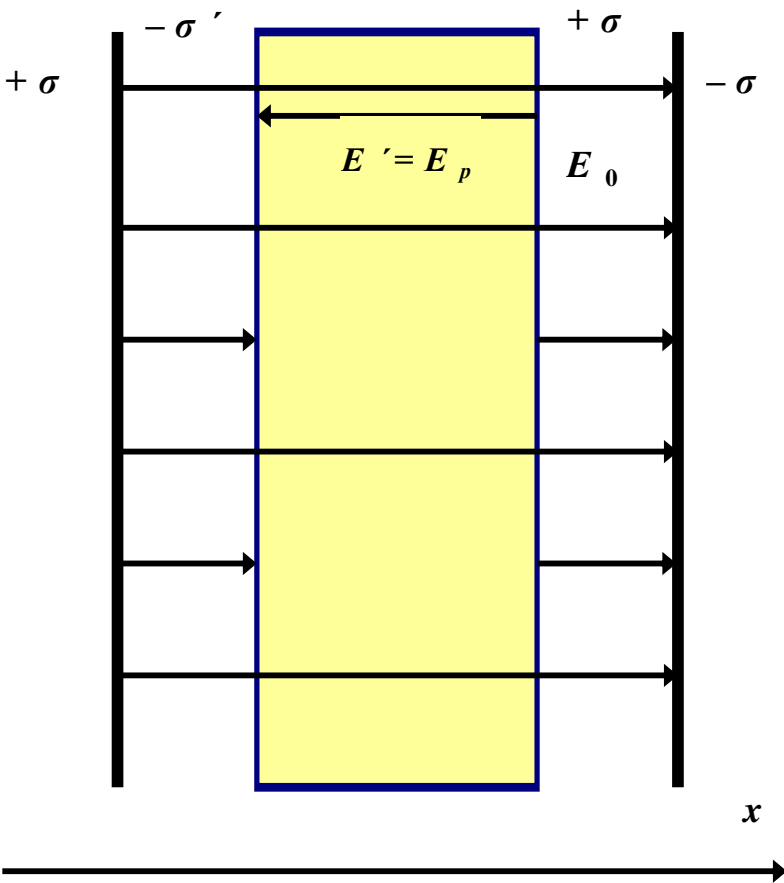
$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}}$$

Связь между векторами D и E

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

Вектор D характеризует установившееся **электрическое поле**, создаваемое свободными зарядами, но при таком их распределении, какое имеет место при наличии диэлектрика.

Относительная диэлектрическая проницаемость

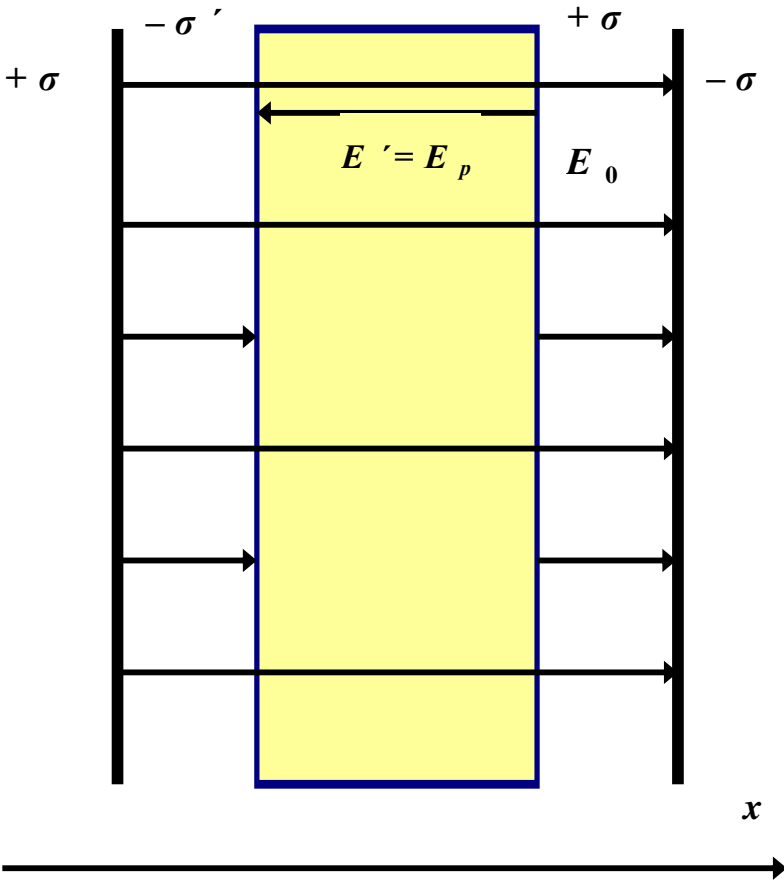


Внешнее поле E_0 создается двумя бесконечными пластинами с поверхностной плотностью заряда $+\sigma$ и $-\sigma$.

Результирующее поле в диэлектрике

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

Относительная диэлектрическая проницаемость



В проекциях на ось x :

$$E = E_0 - E'$$

$$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$

$$E = E_0 - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$

$$P = \sigma' \quad \vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

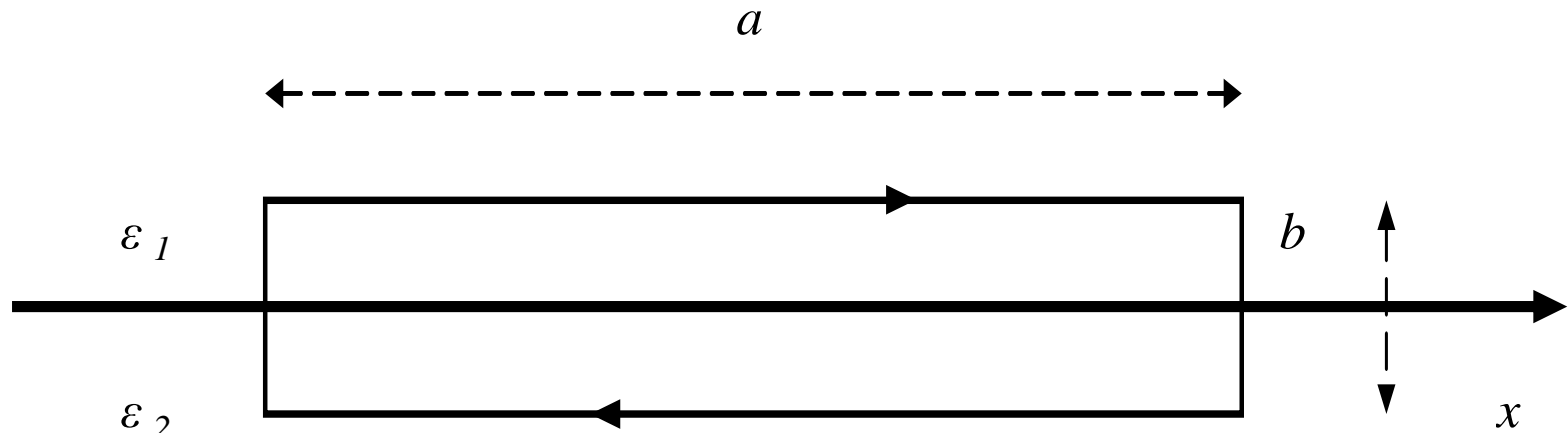
Относительная диэлектрическая проницаемость

$$E = E_0 - \frac{\chi \varepsilon_0 E}{\varepsilon_0} \quad E_0 = (1 + \chi)E \quad \varepsilon = 1 + \chi$$

$$\varepsilon = \frac{E_0}{E}$$

Относительная диэлектрическая проницаемость среды показывает во сколько раз поле в вакууме E_0 больше поля E в среде.

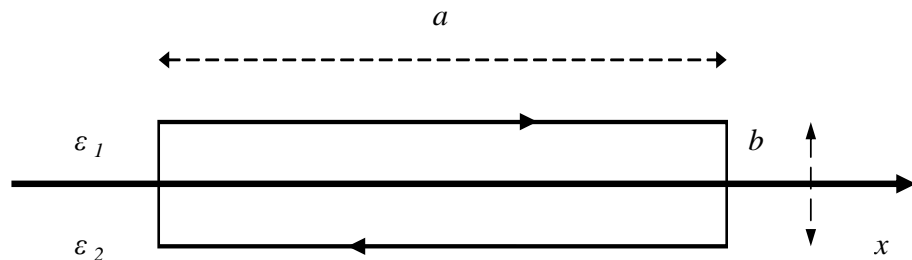
Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



Прямоугольный контур $a \times b$

Два соприкасающихся диэлектрика с различными диэлектрическими проницаемостями ε_1 и ε_2 , помещенные во внешнее электрическое поле.

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



Циркуляция вектора \vec{E}
по замкнутому контуру

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = E_{1x}a - E_{2x}a + \langle E_n \rangle 2b$$

$$E_{1x} = E_{1\tau} \quad E_{2x} = E_{2\tau}$$

тангенциальные составляющие \vec{E} в 1 и 2 диэлектрике

$\langle E_n \rangle$ – среднее значение \vec{E} на участках контура перпендикулярных к границе.

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0 = E_{1x}a - E_{2x}a + \langle E_n \rangle 2b$$

$$(E_{2\tau} - E_{1\tau}) \cdot a = \langle E_n \rangle \cdot 2b$$

Сторона b контура мала: $b \rightarrow 0$.

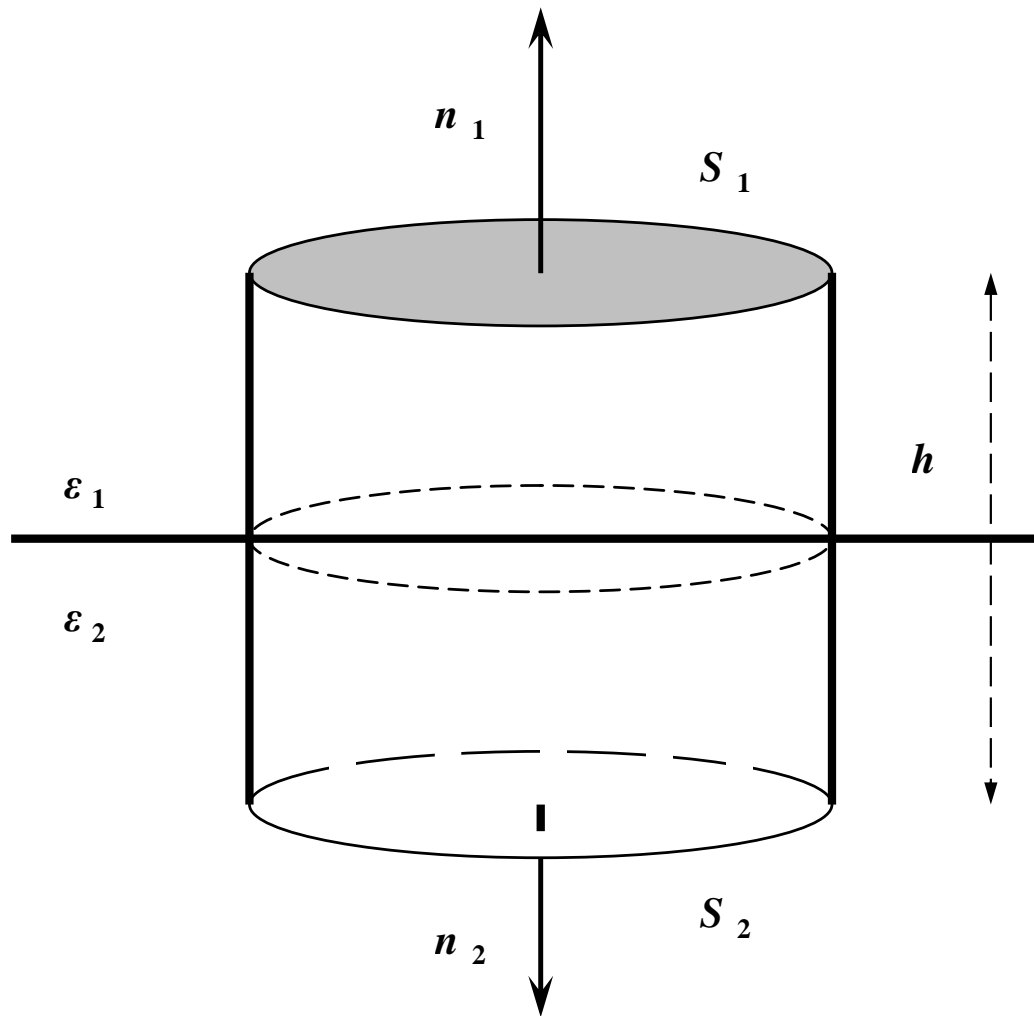
$$(E_{2\tau} - E_{1\tau}) \cdot a = 0$$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

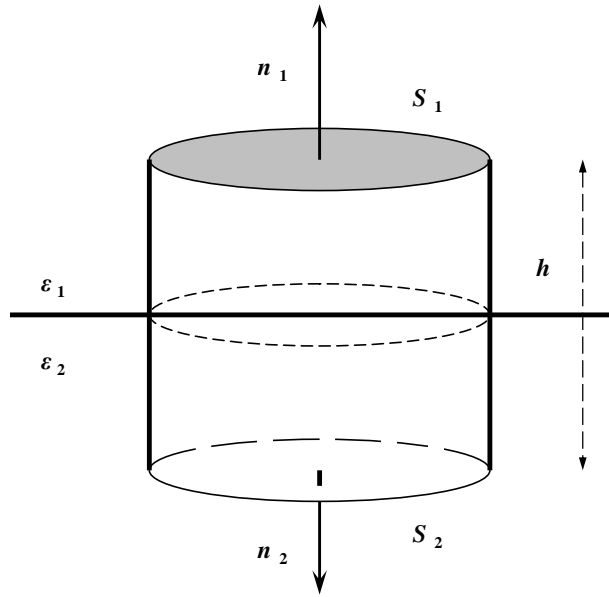
Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



Возьмем на границе
цилиндрическую
поверхность высотой h .

Основание S_1 расположено в первом диэлектрике,
 S_2 – во втором диэлектрике.

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



$$S_1 = S_2 = S \rightarrow 0.$$

Поле в пределах S - однородное.

Сторонних зарядов на границе
2-х диэлектриков нет.

$$\Phi_D = \sum q_i = 0$$

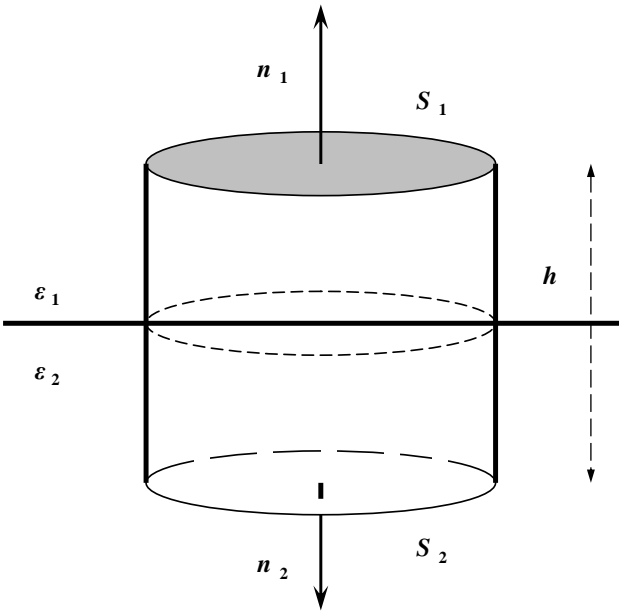
$$\Phi_D = D_{1n} S_{осн} + D_{2n} S_{осн} + \langle D_\tau \rangle S_{бок} = 0$$

D_{1n} – проекция вектора \mathbf{D} в первом диэлектрике на нормаль \mathbf{n}_1 ,

D_{2n} – проекция вектора \mathbf{D} во втором диэлектрике на нормаль \mathbf{n}_2 ,

$\langle D_\tau \rangle$ – значение \mathbf{D} , усредненное по всей боковой поверхности.

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



$$\Phi_D = D_{1n}S + D_{2n}S + \langle D_\tau \rangle S_{бок} = 0$$

$$h \text{ мала } (h \rightarrow 0) \quad S_{бок} \rightarrow 0.$$

$$D_{1n} = -D_{2n}$$

Если рассмотреть проекции векторов D_1 и D_2 на одну и ту же нормаль

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$\frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

При переходе через границу раздела двух сред

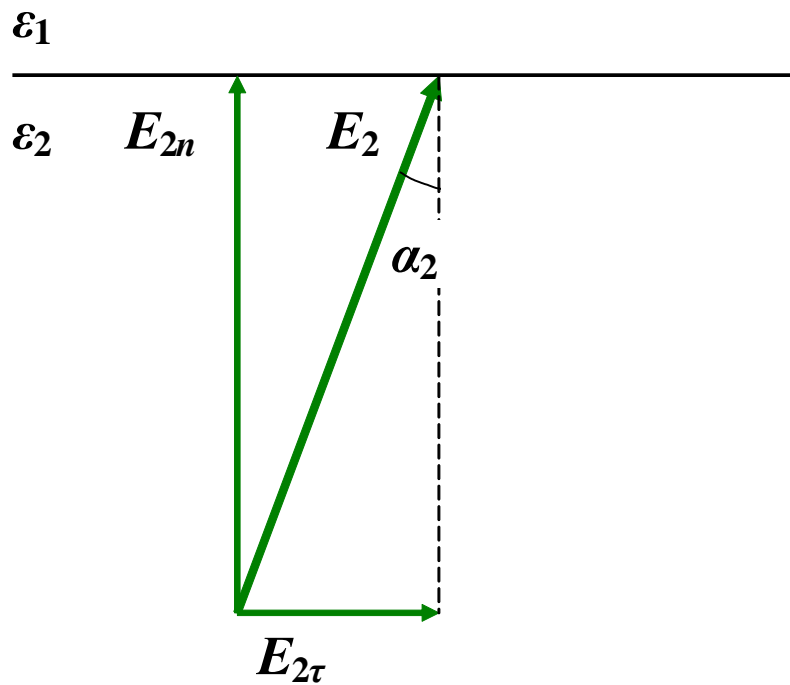
D_n и E_τ изменяются непрерывно
(не претерпевают скачка)

D_τ и E_n претерпевают разрыв

Следствием этого является то, что линии напряженности электрического поля E и линии смещения D на границе двух диэлектриков претерпевают излом.

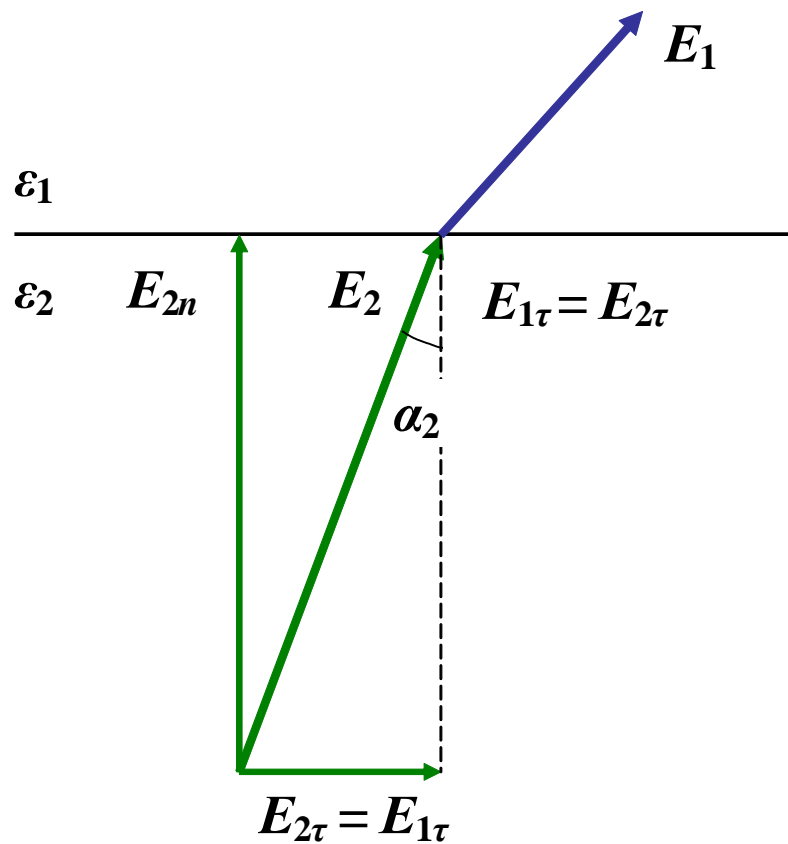
Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



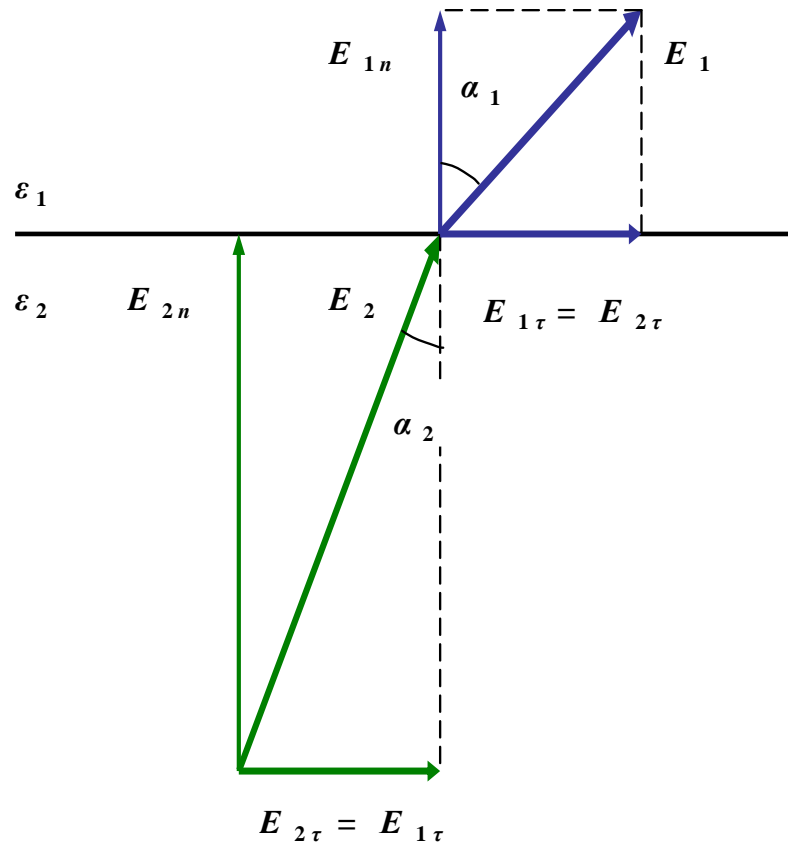
Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

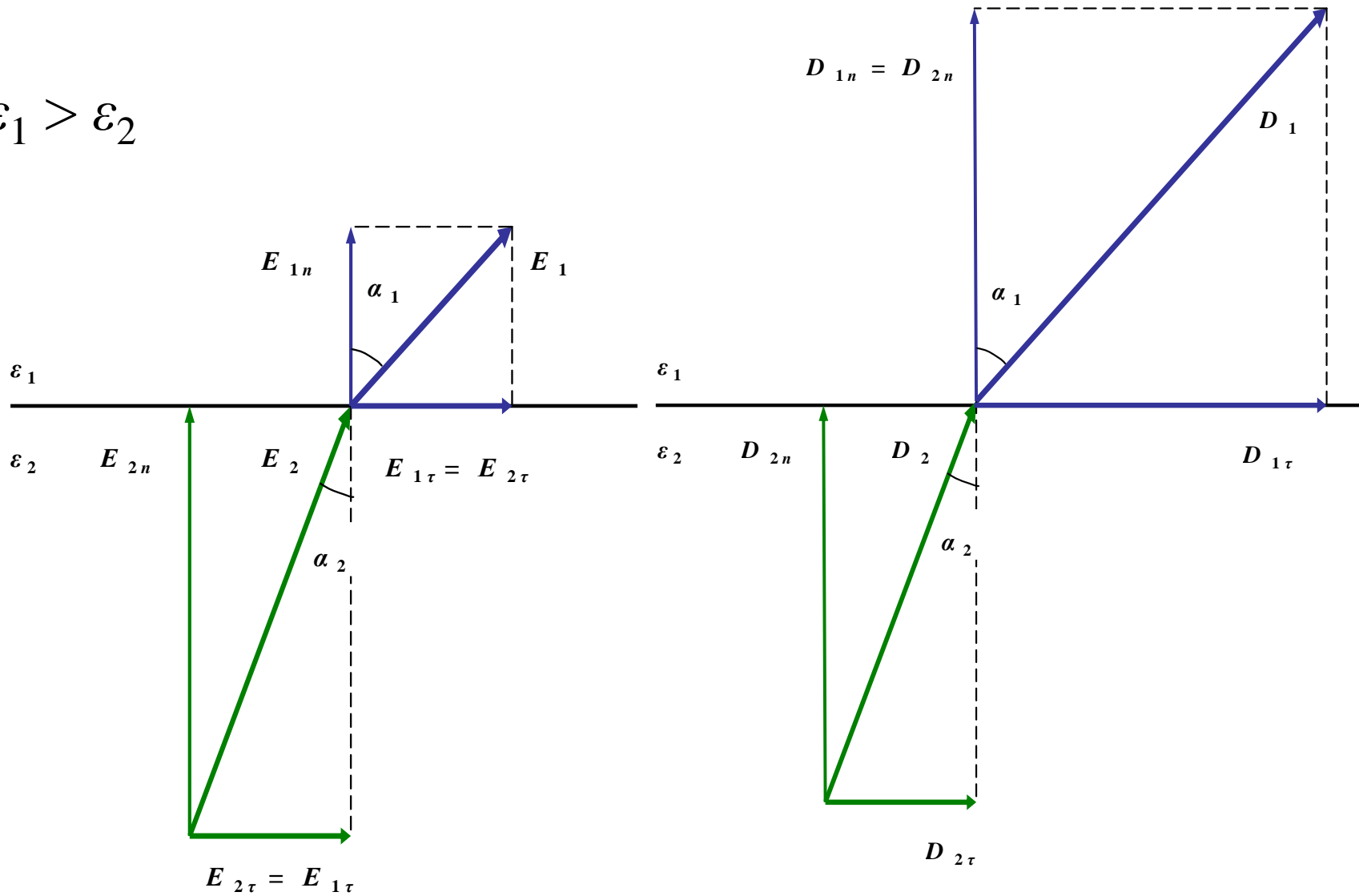
$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



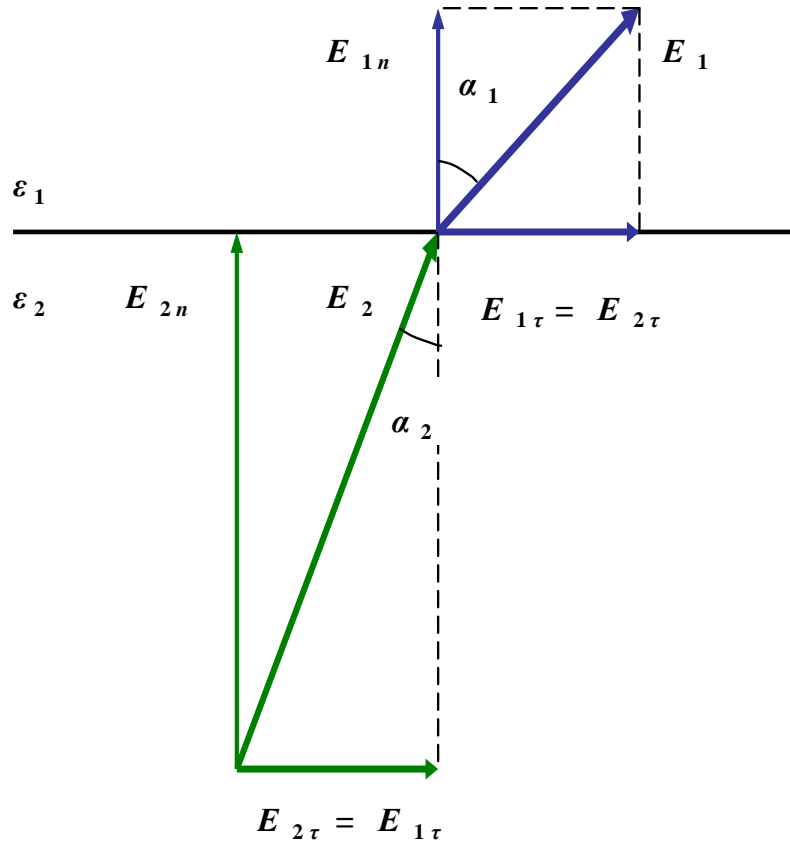
При переходе в диэлектрик с большим ε линии E и D удаляются от нормали

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{\frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}}{\frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

Сегнетоэлектрики

- Существует группа веществ, которые обладают спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в отсутствие внешнего электрического поля.

Это явление было
открыто первоначально
для сегнетовой соли
 $KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$



Сегнетоэлектрики

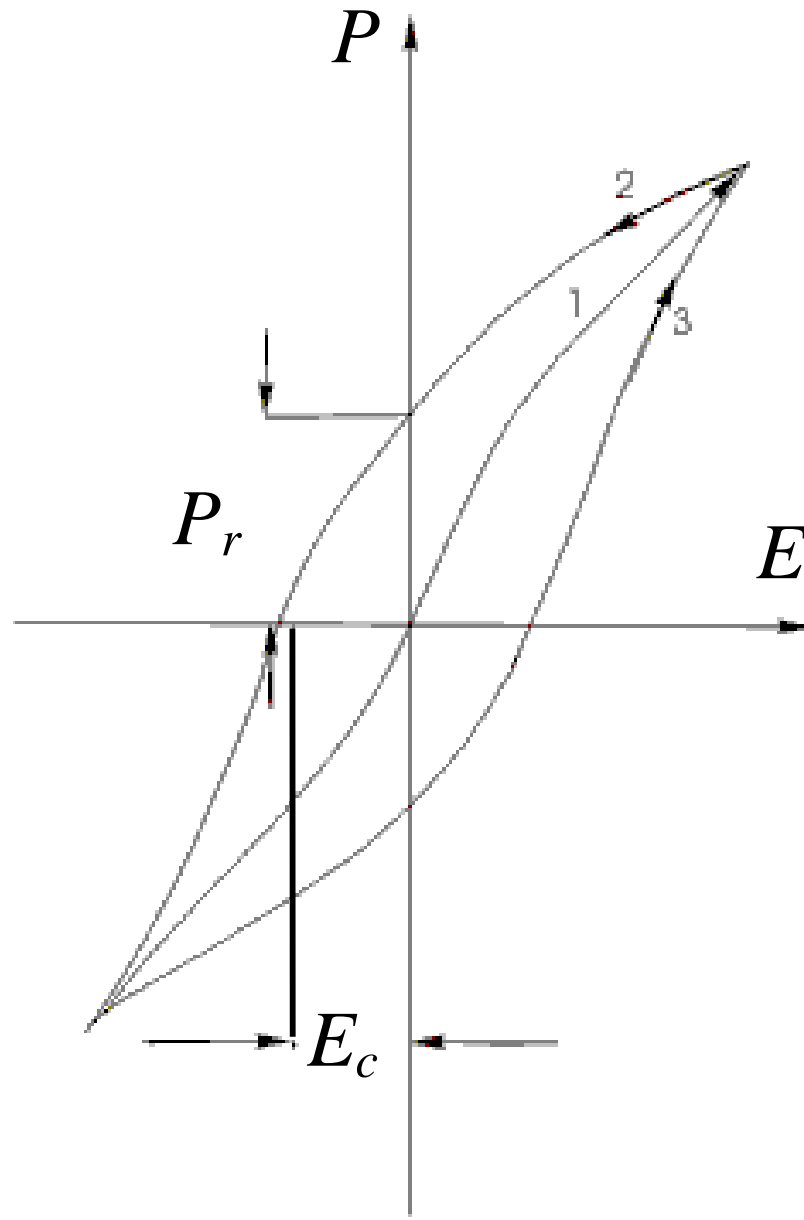
Характерные особенности:

1. для сегнетовой соли $\varepsilon=10000$
2. Зависимость $D=f(E)$ не является линейной
3. При изменении поля значения вектора поляризации P отстают от напряженности поля E , в результате чего P определяется не только величиной E в данный момент, но и предшествующими значениями E .

Это явление называется **гистерезисом**.

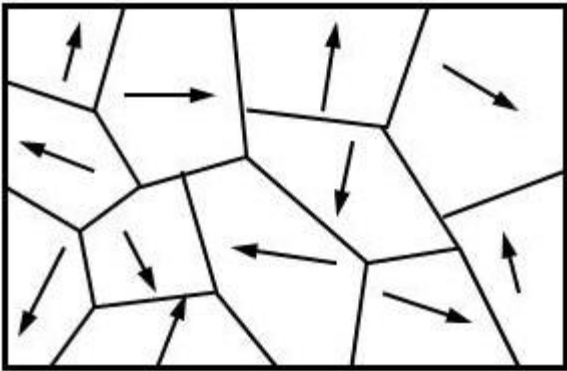
Сегнетоэлектрики

$$P=f(E)$$



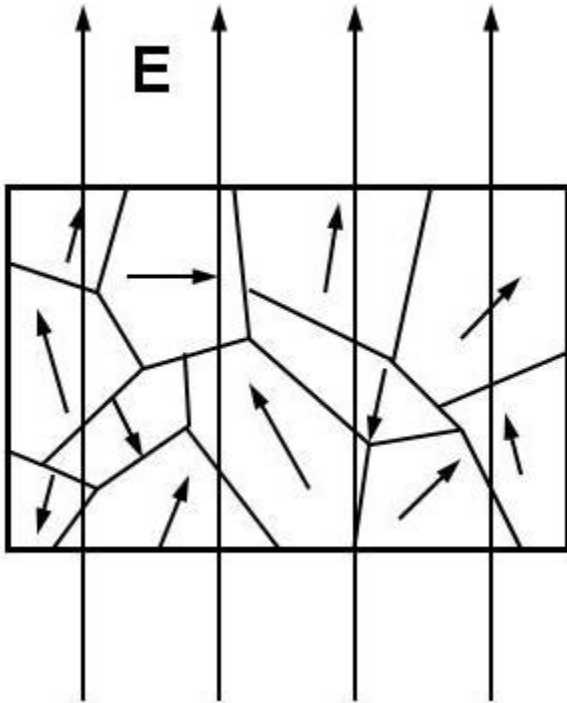
Сегнетоэлектрики

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, в которых есть области *спонтанной поляризации* (**домены**), созданные силами хим. связей в кристалле.



Сегнетоэлектрики

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, в которых есть области *спонтанной поляризации* (**домены**), созданные силами хим. связей в кристалле.



Под действием внешнего электрического поля моменты доменов поворачиваются как целое, устанавливаясь в направлении поля.

Для каждого сегнетоэлектрика есть температура (*точка Кюри*), выше которой вещество утрачивает свои «особые» свойства.

Пьезоэлектрики

Прямой и обратный пьезоэлектрический эффекты

Самостоятельно!

Проводники в электрическом поле

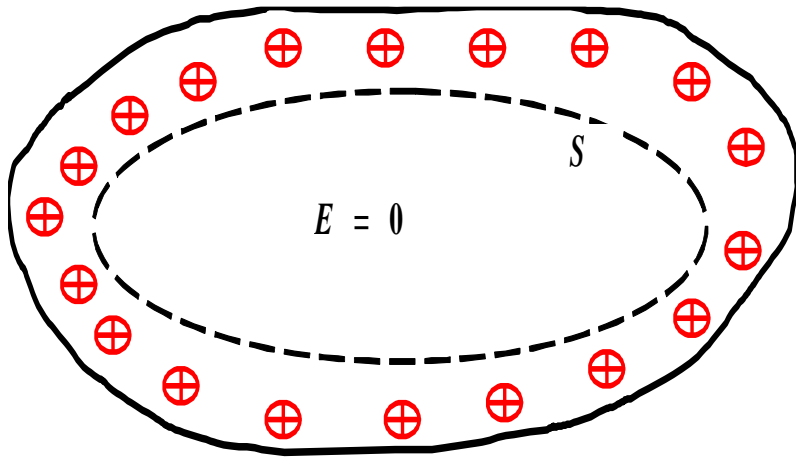
Проводники

В проводниках имеются электрически заряженные частицы – *носители заряда*, которые способны под действием внешнего электрического поля перемещаться по всему объему проводника.

Носителями зарядов в твердых металлических проводниках являются электроны, которые называются *электронами проводимости* или *свободными электронами*.

Равновесие зарядов в проводниках.

Проводнику сообщили заряд $+q$

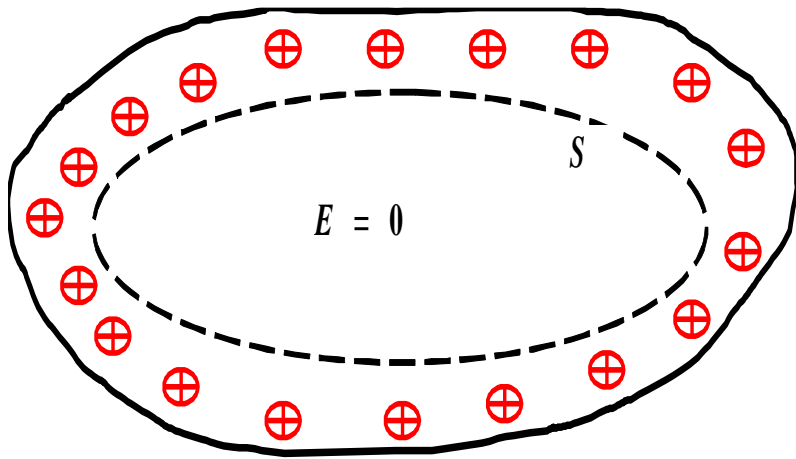


$$\vec{E} = 0$$

Если бы между любыми произвольно выбранными двумя точками проводника существовало поле, то возник бы и **электрический ток** без источника, что **противоречит** закону сохранения энергии.

Равновесие зарядов в проводниках.

Проводнику сообщили заряд $+q$



$$\vec{E} = 0$$

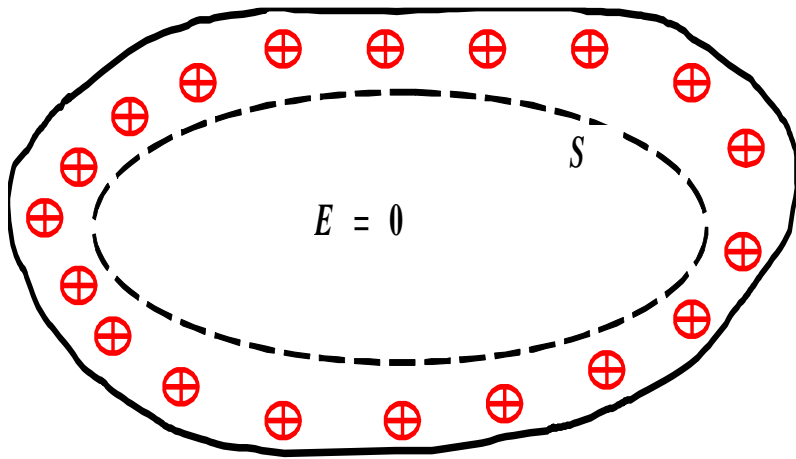
$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_V \frac{\rho dV}{\epsilon_0} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

S – произвольная замкнутая
поверхность внутри проводника

$$\vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = 0$$

Равновесие зарядов в проводниках.

Проводнику сообщили заряд $+q$



$$\rho = 0$$

В объеме проводника избыточные **заряды** отсутствуют и могут находиться только **на внешней поверхности проводника**.

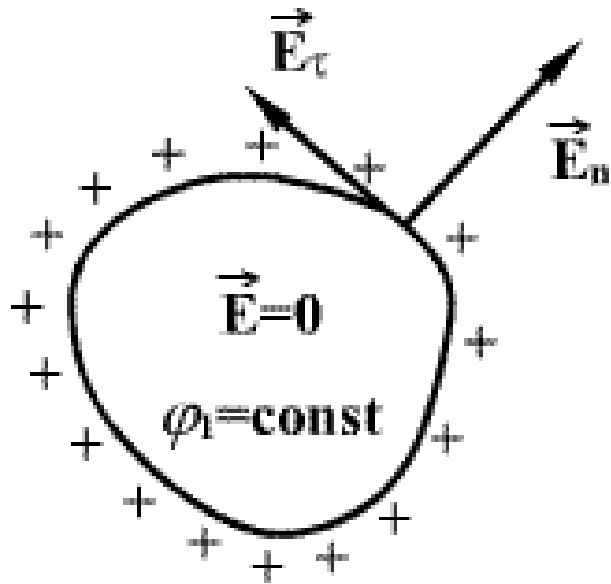
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$$

$$\vec{E} = 0$$

$$\varphi = \text{const}$$

Любой **проводник** представляет собой **эквипотенциальное тело**, а его поверхность, естественно, является *эквипотенциальной*.

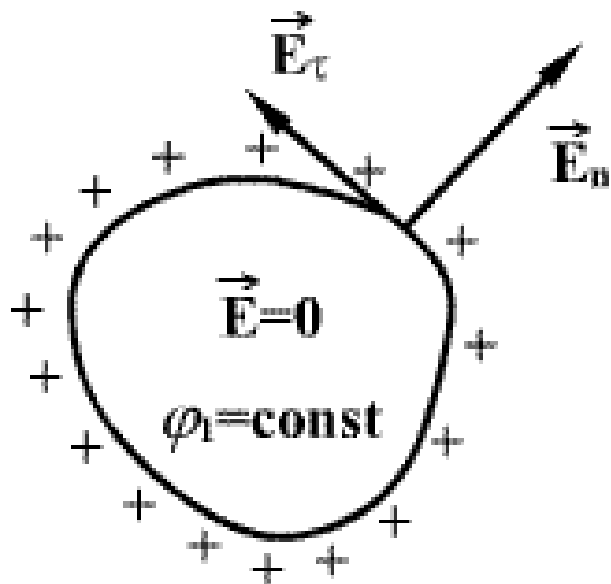
Равновесие зарядов в проводниках.



На поверхности проводника вектор E должен быть направлен по нормали к этой поверхности.

Иначе под действием тангенциальной составляющей вектора напряженности E_τ заряды бы перемещались по проводнику, что противоречит их статическому распределению.

Равновесие зарядов в проводниках.



В равновесном состоянии:

1) $E_{\text{внутр}} = E = 0.$

$$\vec{E} = -\text{grad}\varphi = -\vec{\nabla}\varphi$$

2) $\varphi_{\text{внутр}} = \text{const}$ весь объем проводника и его поверхность **эквипотенциальны**.

3) На поверхности проводника $\vec{E} = \vec{E}_n, \quad \vec{E}_\tau = 0.$

4) $\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E} \quad \longrightarrow \quad \vec{D}_{\text{внутр}} = 0$